

УДК 744:621.382:003.62:006.354

Группа Т52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система конструкторской документации

**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
В СХЕМАХ.**

ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

ГОСТ

2.730—73

Unified system for design documentation.
Graphical symbols in diagrams.
Semiconductor devices

Дата введения 1974—07—01

1. Настоящий стандарт устанавливает правила построения условных графических обозначений полупроводниковых приборов на схемах, выполняемых вручную или автоматическим способом во всех отраслях промышленности.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Обозначения элементов полупроводниковых приборов приведены в табл. 1.







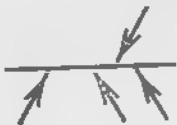
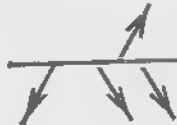

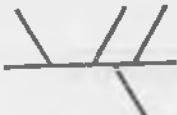
НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**








Издание официальное








Перепечатка воспрещена

Наименование	Обозначение
1. (Исключен, Изм. № 2). 2. Электроды: база с одним выводом	
база с двумя выводами	 или  , или 
<i>P</i> -эмиттер с <i>N</i> -областью	
<i>N</i> -эмиттер с <i>P</i> -областью	
несколько <i>P</i> -эмиттеров с <i>N</i> -областью	
несколько <i>N</i> -эмиттеров с <i>P</i> -областью	
коллектор с базой	
несколько коллекторов, например, четыре коллектора на базе	

Продолжение табл. 1

Наименование	Обозначение
3. Области: область между проводниковыми слоями с различной электропроводностью. Переход от <i>P</i> -области к <i>N</i> -области и наоборот	
область собственной электропроводности (<i>I</i> -область): 1) между областями с электропроводностью разного типа <i>PIN</i> или <i>NIP</i>	
2) между областями с электропроводностью одного типа <i>PIP</i> или <i>NIN</i>	
3) между коллектором и областью с противоположной электропроводностью <i>PIN</i> или <i>NIP</i>	
4) между коллектором и областью с электропроводностью того же типа <i>PIP</i> или <i>NIN</i>	
4. Канал проводимости для полевых транзисторов: обогащенного типа	
обедненного типа	

Наименование	Обозначение
5. Переход <i>PN</i>	
6. Переход <i>NP</i>	
7. <i>P</i> -канал на подложке <i>N</i> -типа, обогащенный тип	
8. <i>N</i> -канал на подложке <i>P</i> -типа, обедненный тип	
9. Затвор изолированный	
10. Исток и сток Примечание. Линия истока должна быть изображена на продолжении линии затвора, например:	